1. (a) の回路における電力の導出

入力電圧の最大値を
$$E_m$$
とすると $e=E_m\sin\omega t$ $i=\frac{e}{R}=\frac{E_m}{R}\sin\omega t$ $ei=E_m\sin\omega t\cdot\frac{E_m}{R}\sin\omega t$ $=\frac{E_m^2}{R}\sin^2\omega t$ $=\frac{E_m^2}{R}(1-\cos2\omega t)$ $E=\frac{E_m}{\sqrt{2}}$ より、 $E_m^2=2E^2$ であるから、 $ei=ei_R=\frac{E^2}{R}(1-\cos2\omega t)$

2. (b) の回路における電力の導出

$$e = \sqrt{2}E \sin \omega t$$
 インダクタンス L [H] に流れる電流を i [A] とすると、誘導起電力 e_L [V] は $e_L = -L\frac{di}{dt}$ $e + e_L = 0$ が成り立つため、 $e = L\frac{di}{dt}$ $\frac{e}{L}dt = di$ $\int di = \int \frac{e}{L}dt$ $i = \int \left(\sqrt{2}E \sin \omega t dt\right)$ $= -\sqrt{2}\frac{E}{\omega L}\cos \omega t$ $= \sqrt{2}\frac{E}{\omega L}\sin (\omega t - \frac{\pi}{2})$ $ei = \frac{2E^2}{\omega L}\sin \omega t \cdot \sin (\omega t - \frac{\pi}{2})$ 積和の公式 $\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2}\left(\cos (\alpha + \beta) - \cos (\alpha - \beta)\right)$ を用いて変形すると $ei = \frac{2E^2}{\omega L}\left(-\frac{1}{2}\left(\cos \left(\omega t + \omega t - \frac{\pi}{2}\right)\right)\right)$ $= -\cos \left(\omega t - \omega t + \frac{\pi}{2}\right)$)) $= -\frac{E^2}{\omega L}\cos \left(2\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$

3. (c) の回路における電力の導出

$$e = \sqrt{2}E \sin \omega t$$

静電容量 C [F] に加わる電圧を v [V]
とすると, 流れる電流 i [A] は
 $i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}Cv$
 $= C\frac{d\left(\sqrt{2}E\sin \omega t\right)}{dt}$
 $= \sqrt{2}\omega CE\cos \omega t$
これらから, 電力 ei は
 $ei = 2E^2\omega C\sin \omega t\cos \omega t$
 $= E^2\omega C\sin (2\omega t)$

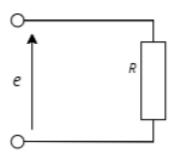


Figure 1: 回路 a

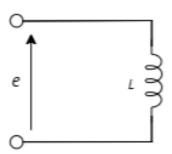


Figure 2: 回路 b

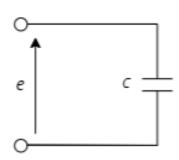


Figure 3: 回路 c

4. (d) の回路における電力の導出

$$e = \sqrt{2}E\sin\omega t$$

また、各素子の電圧降下の合成と考えると

$$e = iR + L\frac{di}{dt}$$
とも表すことができる.

抵抗とインダクタンスの合成インピーダンスを Z, 合成インピーダンスの位相のずれを Φ とすると電流 i は、

$$i = \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}\sin\left(\omega t - \Phi\right)$$

このiを用いて電力eiを表すと,

$$ei = \sqrt{2}E \sin \omega t \cdot \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \sin (\omega t - \Phi)$$
$$= \frac{2E^2}{\|Z\|} \sin \omega t \sin (\omega t - \Phi)$$

加法定理を用いて, $\sin(\omega t - \Phi)$ を変形すると

$$ei = \frac{2E^2}{\|Z\|} \sin \omega t \left(\sin \omega t \cos \Phi - \cos \omega t \sin \Phi\right)$$
$$= \frac{2E^2}{\|Z\|} \left(\sin^2 \omega t \cos \Phi - \sin \omega t \cos \omega t \sin \Phi\right)$$
$$= \frac{2E^2}{\|Z\|} \left(\sin^2 \omega t \cos \Phi\right) - \frac{2E^2}{\|Z\|} \left(\sin \omega t \cos \omega t \sin \Phi\right)$$

左の項には sin の半角公式

右の項には $\sin \alpha \cos \beta$ の積和公式を用いて変形すると

$$ei = \frac{2E^2}{\|Z\|} \left(\left(\frac{1 - \cos 2\omega t}{2} \right) \cos \Phi \right)$$
$$- \frac{2E^2}{\|Z\|} \left(\frac{1}{2} \left(\sin 2\omega t + \sin 0 \right) \sin \Phi \right)$$
$$= \frac{E^2}{\|Z\|} \cos \Phi \left(1 - \cos 2\omega t \right) - \frac{E^2}{\|Z\|} \sin \Phi \sin 2\omega t$$

また、各素子における電力を求める。

抵抗での電圧降下 e_R は、

$$e_{R} = iR = \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}R\sin\left(\omega t - \Phi\right)$$

であるから.

$$ei_R = \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}R\sin(\omega t - \Phi) \cdot \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}\sin(\omega t - \Phi)$$
$$= \frac{2E^2}{\|Z\|^2}R\sin^2(\omega t - \Phi)$$

半角の公式を用いて

$$\begin{split} &=\frac{2E^2}{\|Z\|^2}R\left(\frac{1-\cos2\left(\omega t-\Phi\right)}{2}\right)\\ &=\frac{E^2}{\|Z\|^2}R\left(1-\cos2\left(\omega t-\Phi\right)\right) \end{split}$$

R と ωL との位相差は $\frac{\pi}{2}$ であり,

合成インピーダンス Z の位相差を Φ とすると、

$$\begin{split} \frac{R}{\|Z\|} &= \cos \Phi \, \mathcal{E} \, \mathcal{T} \, \mathcal{S} \, \mathcal{E} \, \mathcal{B}, \\ ei_R &= \frac{E^2}{\|Z\|} \cos \Phi \, (1 - \cos 2 \, (\omega t - \Phi)) \\ \mathcal{R} \, \mathcal{E} \, \mathcal{I} \, \mathcal{V} \, \mathcal{T} \, \mathcal{O} \, \mathbb{E} \, \mathbb{E} \, \mathbb{E} \, \mathcal{E} \, \mathcal{L} \, \mathcal{A}, \\ e_L &= L \frac{di}{dt} = L \frac{d}{dt} \left(\frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \sin \left(\omega t - \Phi\right) \right) \\ &= \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \omega L \cos \left(\omega t - \Phi\right) \\ &= \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \omega L \cos \left(\omega t - \Phi\right) \cdot \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|} \sin \left(\omega t - \Phi\right) \\ &= \frac{2E^2}{\|Z\|^2} \omega L \cos \left(\omega t - \Phi\right) \sin \left(\omega t - \Phi\right) \\ &= \frac{2E^2}{\|Z\|^2} \omega L \cos \left(\omega t - \Phi\right) \sin \left(\omega t - \Phi\right) \\ &= \frac{2E^2}{\|Z\|^2} \omega L \left(\frac{1}{2} \left(\sin 2\omega t - 2\Phi\right) \right) \\ &= \frac{E^2}{\|Z\|^2} \omega L \left(\sin 2\omega t - 2\Phi\right) \\ &\mathbb{E} \, \mathcal{E}, \frac{\omega L}{\|Z\|} = \sin \Phi \, \mathcal{E} \, \mathcal{T} \, \mathcal{S} \, \mathcal{E} \, \mathcal{B}, \\ ei_L &= \frac{E^2}{\|Z\|^2} \sin \Phi \, \left(\sin 2\omega t - 2\Phi\right) \end{split}$$

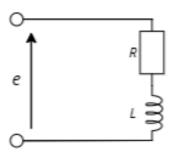


Figure 4: 回路 d

5. (e) の回路における電力の導出

$$e=\sqrt{2}E\sin\omega t$$

並列接続であるから、抵抗および
インダクタンスにかかる電圧は等しいので、
 $e=e_R=e_L$
また、各素子における電圧降下で考えると、
 $e=i_RR=L\frac{di_L}{dt}$

抵抗に流れる電流は、オームの法則より、

$$i_R = \frac{e}{R}$$
$$= \frac{\sqrt{2}E}{R}\sin\omega t$$

インダクタンスに流れる電流は,

$$e = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\frac{e}{L}dt = di_L$$

$$\int di_L = \int \frac{e}{L} dt$$

$$i_L = \frac{\sqrt{2}E}{L} \int \sin \omega t dt$$

$$= -\frac{\sqrt{2}E}{\omega L}\cos\omega t$$

ところで、合成アドミタンスYは、

$$\begin{split} Y &= \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} \\ &= \frac{1}{R} - j\frac{1}{\omega L} \\ \|Y\| &= \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{\omega L}\right)^2} \end{split}$$

つまり, 合成インピーダンス Z は、

$$||Z|| = \frac{\omega LR}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

電圧を基準として電流の位相差をを考えると、 電圧と同位相である $\frac{1}{R}$ と、 $-\frac{\pi}{2}$ ずれている $\frac{1}{\omega L}$ によって得られる電流は Y の位相であるため、Y の位相を Φ とすると、

$$\begin{split} \cos\Phi &= \frac{\frac{1}{R}}{\|Y\|} = \frac{\|Z\|}{R} \Rightarrow \frac{1}{R} = \frac{\cos\Phi}{\|Z\|} \\ \sin\Phi &= \frac{\frac{1}{\omega L}}{\|Y\|} = \frac{\|Z\|}{\omega L} \Rightarrow \frac{1}{\omega L} = \frac{\sin\Phi}{\|Z\|} \end{split}$$

となる、これらから電流 inと.irを変形すると

$$i_{R} = \frac{\sqrt{2}E}{R}\sin\omega t$$

$$= \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}\cos\Phi\sin\omega t$$

$$i_{L} = -\frac{\sqrt{2}E}{\omega L}\cos\omega t$$

$$= -\frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}\sin\Phi\cos\omega t$$

となり、式 3.17、式 3.18 が得られ、各素子の電力は、

6. (f) の回路における電力の導出

$$e = \sqrt{2}E\sin\omega t$$

ここで、各素子の合成インピーダンスを考える.

$$Z_{R1} = R_1$$

$$Z_{RL} = R_2 + j\omega L$$

であるから、並列接続部分の合成インピーダンスは、

$$\frac{1}{Z_p}=\frac{1}{Z_{R1}}+\frac{1}{Z_{RL}}$$

回路全体の合成インピーダンスを Z とすると,

$$Z = R_0 + Z_p$$

Zの位相を Φ とすると、回路に流れる電流 i_s は、

$$i_s = \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}\sin\left(\omega t - \Phi\right)$$

となり,電力は

$$ei = \sqrt{2}E\sin\omega t \cdot \frac{\sqrt{2}E}{\|Z\|}\sin(\omega t - \Phi)$$

$$E^{2}$$

 $=\frac{E^2}{\|Z\|}\cos\Phi\left(1-\cos2\omega t\right)-\frac{E^2}{\|Z\|}\sin\Phi\sin2\omega t$ また、各素子の電力は、その素子に流れる電流、

その素子にかかる電圧、その素子のインピーダンスによって立式されている.